

特征

激光修剪到高精度

5.000 V $\pm$ 2.0 mV (M级)

修整温度系数

最高2 ppm/ $^{\circ}$ C, 0 $^{\circ}$ C至70 $^{\circ}$ C (M等级)

最高5 ppm/ $^{\circ}$ C, -40 $^{\circ}$ C至+ 85 $^{\circ}$ C (B和L等级)

最高10 ppm/ $^{\circ}$ C, -55 $^{\circ}$ C至+ 125 $^{\circ}$ C (T等级)

低噪音, 100 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$

降噪能力

输出微调功能

符合MIL-STD-883标准的版本

工业温度范围SOICs可利用

输出能够输出或吸收10 mA

一般描述

AD586代表了最先进的一项重大进步单片电压基准.使用专有的离子植入埋置齐纳二极管和高稳定性的激光晶圆微调薄膜电阻, AD586提供了出色的性能, 昂贵的成本.

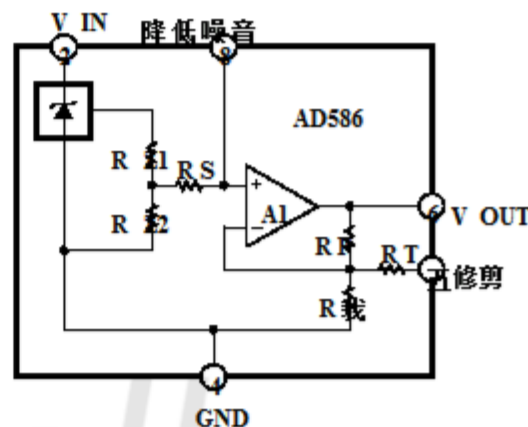
AD586的性能比其他产品高得多
5 V参考 因为AD586采用工业标准
许多系统可以立即升级
AD586.

嵌入齐纳方法参考设计提供较低
噪声和漂移比带隙电压基准. AD586
提供可用于进一步降低的降噪引脚
埋入齐纳产生的噪声电平.

推荐使用AD586作为8位, 10位,
12位, 14位或16位DAC, 需要外部精确度
参考.该设备也是逐次逼近的理想选择
或者将ADC与14位精度进行集成,
一般来说, 可以提供比标准片上更好的性能
引用.

AD586J, AD586K, AD586L和AD586M指定用于
从0 $^{\circ}$ C到70 $^{\circ}$ C的操作; AD586A和AD586B都是
指定为-40 $^{\circ}$ C至+ 85 $^{\circ}$ C的操作;和AD586S和
AD586T的额定工作电压为-55 $^{\circ}$ C至+ 125 $^{\circ}$ C.

AD586J, AD586K, AD586L和AD586M可在
8引脚PDIP; AD586J, AD586K, AD586L, AD586A和
AD586B采用8引脚SOIC封装, 和
AD586J, AD586K, AD586L, AD586S和AD586T
采用8引线CERDIP封装.



笔记
1. 引脚1, 3和7是内部测试点.
不要与这些要点连接.

图1.

产品聚焦

1. 激光微调初始精度和温度系数导致温度误差非常低
无需使用外部组件. AD586M有
5.000 V之间的最大偏差为 $\pm$ 2.45 mV之间
0 $^{\circ}$ C和70 $^{\circ}$ C, AD586T保证 $\pm$ 7.5 mV
最大总误差在-55 $^{\circ}$ C和+ 125 $^{\circ}$ C之间.
2. 对于要求更高精度的应用, 可选
提供精细连接.
3. 任何使用行业标准引脚排列的系统
可以通过AD586立即升级.
4. AD586的输出噪声非常低, 典型值为4 μ Vpp.
提供降噪引脚用于增加噪声
使用外部电容进行滤波.
5. AD586提供兼容的版本
MIL-STD-883.请参阅“模拟器件军事”
产品数据手册或目前的AD586 / 883B数据手册
详细的规格.

教师G

ADI公司提供的信息被认为是准确和可靠的.
但是, ADI公司不承担任何责任, 也不承担任何责任
侵犯第三方可能因其使用而导致的专利或其他权利.
规格如有变更, 恕不另行通知. 没有许可证的暗示.
或以其他方式根据ADI公司的任何专利或专利权. 商标和
注册商标是其各自所有者的财产.

目录

规格.....	3	负载调整.....	9
AD586J, AD586K / AD586A, AD586L / AD586B	3	温度性能.....	9
AD586M, AD586S, AD586T	4	AD586的负参考电压.....	10
绝对最大额定值.....	5	将AD586与转换器一起使用.....	10
ESD警告.....	5	采用CMOS DAC或ADC的5 V基准.....	11
引脚配置和功能描述.....	6	多个电压的堆叠精密基准.....	11
操作理论.....	7	精密电流源.....	11
应用AD586	7	精密高电流供电.....	11
噪音表现和减少.....	7	外形尺寸.....	13
开启时间.....	8	订购指南.....	14
动态性能.....	8		

修订记录

3月5日-REV. F到Rev. G	
更新格式.....	普遍
拆分规格表到表1和表2	3
表1的变更.....	3
添加了图2和图4	6
更新了外形尺寸.....	13
订购指南的更改.....	14
1/04-REV. E至Rev. F	
订购指南的变更.....	3
7/03-REV. D至Rev.E	
删除了AD586J CHIPS	普遍
更新了订购指南.....	3
转到图3	4
更新了图12	7
更新了外形尺寸.....	9
4月1日-REV. C到Rev. D	
将图10更改为表1	
(以mV为单位的最大输出变化)	6
11 / 95-版本0: 初始版本	

规格

AD586J, AD586K / AD586A, AD586L / AD586B

除非另有说明, @ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{IN} = 15\text{ V}$ 在最后的电气测试中, 粗体规格在所有生产单元上进行测试. 结果

从那些测试被用来计算出去的质量水平. 所有的最小和最大规格是保证, 但只有

除非另有说明, 用黑体字表示的部分均在所有生产单位上进行测试.

表格 1.

参数	AD586J			AD586K / AD586A			AD586L / AD586B			单元
	敏	典型	马克斯	敏	典型	马克斯	敏	典型	马克斯	
输出电压	4.980		5.020	4.995		5.005	4.9975		5.0025	V
输出电压 DRIFT1 0°C至70°C			25			15			五	PPM/°C
-55°C至+125°C										PPM/°C
增益调整	+6			+6			+6			%
	-2			-2			-2			%
行规1 10.8 V <+ V_{IN} <36 V T MIN 到 T MAX			±100			±100			±100	μV/V
11.4 V <+ V_{IN} <36 V T MIN 到 T MAX										μV/V
负载调节1 采购0 mA < I_{OUT} <10 mA 25°C下			100			100			100	μV/毫安
T MIN 到 T MAX			100			100			100	μV/毫安
吸收-10 mA < I_{OUT} <0 mA 25°C下			400			400			400	μV/毫安
静止电流	2		3	2		3	2		3	嘛
能量消耗	三十			三十			三十			毫瓦
输出噪声 0.1Hz至10Hz	4			4			4			μVpp
谱密度, 100 Hz	100			100			100			纳伏/√Hz的
长期稳定性	15			15			15			ppm / 1000小时
短路 CURRENT-TO-GROUND	45		60	45		60	45		60	嘛
温度范围 指定的性能2	0		70	0	(K级)	70	0	(L级)	70	C
				-40	(一个品级)	+85	-40	(B级)	+85	C
经营业绩3	-40		+85	-40		+85	-40		+85	C

1 所有封装和等级的最大输出电压漂移保证. CERDIP封装零件也经过100°C生产测试.

2 下排显示A和B等级的指定性能.

3 工作温度范围定义为设备仍能工作的极限温度. 零件可能偏离其指定的性能超出其指定的温度范围.

AD586

AD586M, AD586S, AD586T

除非另有说明, @ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{IN} = 15\text{ V}$ 在最后的电气测试中, 粗体规格在所有生产单元上进行测试. 结果从那些测试被用来计算出去的质量水平. 所有的最小和最大规格是保证, 但只有除非另有说明, 用黑体字表示的部分均在所有生产单元上进行测试.

表2

参数	AD586M			AD586S			AD586T			单元
	敏	典型	马克斯	敏	典型	马克斯	敏	典型	马克斯	
输出电压	4.998		5.002	4.990		5.010	4.9975		5.0025	V
输出电压 DRIFT1										
0°C 至 70°C			2			20			10	PPM/ $^{\circ}\text{C}$
-55°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$										PPM/ $^{\circ}\text{C}$
增益调整	+6			+6			+6			%
	-2			-2			-2			%
行规1										
$10.8\text{ V} < V_{IN} < 36\text{ V}$										
T MIN 到 T MAX			± 100							$\mu\text{V/V}$
$11.4\text{ V} < V_{IN} < 36\text{ V}$										
T MIN 到 T MAX						± 150			± 150	$\mu\text{V/V}$
负载调节1										
采购 $0\text{ mA} < I_{OUT} < 10\text{ mA}$										
25°C 下			100			150			150	$\mu\text{V}/\text{毫安}$
T MIN 到 T MAX			100			150			150	$\mu\text{V}/\text{毫安}$
吸收 $-10\text{ mA} < I_{OUT} < 0\text{ mA}$										
25°C 下			400			400			400	$\mu\text{V}/\text{毫安}$
静止电流	2		3	2		3	2		3	嘛
能量消耗	三十			三十			三十			毫瓦
输出噪声										
0.1 Hz 至 10 Hz			4			4			4	μV_{pp}
谱密度,			100			100			100	纳伏/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 的
100赫兹										
长期稳定性			15			15			15	ppm / 1000小时
短路										
CURRENT-TO-GROUND			45 60			45 60			45 60	嘛
温度范围										
指定的性能2	0		70	-55		+125	-55		+125	C
经营业绩3	-40		+85	-55		+125	-55		+125	C

1 所有封装和等级的最大输出电压漂移保证. CERP封装零件也经过 100°C 生产测试.

2 下排显示A和B等级的指定性能.

3 工作温度范围定义为设备仍能工作的极限温度. 零件可能偏离其指定的性能超出其指定的温度范围.

绝对最大额定值

表3.

参数	评分
V _{IN} 接地	36 V
功耗 (25°C)	500毫瓦
储存温度	-65°C至+ 150°C
引线温度 (焊接, 10秒)	300°C
封装热阻	
θ _{JC}	22°C/ W
θ _{JA}	110°C/ W
输出保护	输出安全无限期 对地或V _{IN} 短路。

强调超出绝对最大额定值列出的那些可能会导致设备永久性损坏.这是一个压力只有评级.在这些或任何设备的功能操作其他情况超出业务指标不是暗示本规范的一部分.接触绝对延长期限的最大额定条件可能会影响设备可靠性.

ESD警告

ESD (静电放电) 敏感装置.高达4000V的静电电荷很容易积累在电极上.人体和测试设备, 可以不经检测而放电.虽然这个产品的功能专有的ESD保护电路, 在高能量设备上可能会发生永久性损坏.静电放电.因此, 建议采取适当的ESD防范措施以避免性能下降.功能退化或丧失.



 Ixmall
万联芯城
www.wlxmall.com

引脚配置和功能说明



图2.引脚配置（N-8）



图3.引脚配置（Q-8）

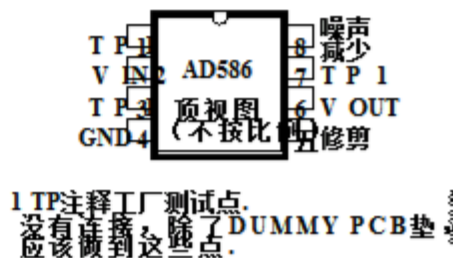


图4.引脚配置（R-8）

表4.引脚功能描述

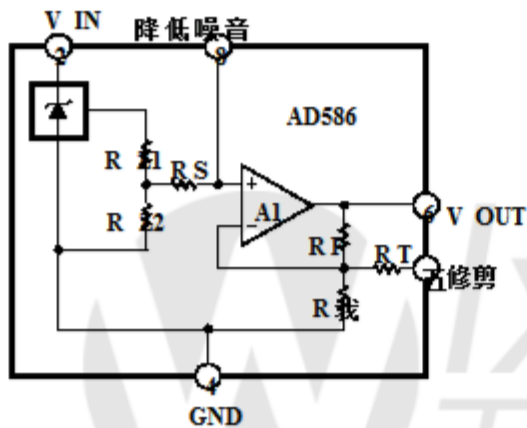
销号	助记符	描述
1	TP 1	工厂修剪垫（无连接）。
2	V IN	输入电压。
3	TP 1	工厂修剪垫（无连接）。
4	GND	地面。
五	修剪	可选的外部精细修剪。请参阅应用AD586部分。
6	V OUT	输出电压。
7	TP 1	工厂修剪垫（无连接）。
8	减少噪音	可选的降噪滤波器，外部1μF电容接地。

操作理论

AD586由专有埋入式齐纳二极管组成，一个放大器来缓冲输出，以及几个高稳定性薄膜电阻器，如图5的框图所示。

这种设计导致高精度单片5 V输出
初始偏移量为2.0mV或更低的参考。气温
补偿电路为设备提供温度
系数低于2 ppm / °C。

在齐纳输出之间使用偏置补偿电阻
和放大器的同相输入端，一个电容可以
添加到降噪引脚（引脚8）形成一个低通
滤波并减少齐纳对噪声的贡献
电路。



笔记
1. 引脚1, 3和7是内部测试点。
不要与这些要点连接。

图5. 功能框图

应用AD586

AD586几乎适用于所有精密基准应用。当引脚2和引脚4上电时，引脚6提供5 V输出。没有外部元件是必要的。达到期望的绝对精度的程度只需选择所需的设备等级。AD586从运行中需要少于3mA的静态电流供应12V或15 V。

可能需要外部精细修剪来设置输出电平正好5.000 V（校准到主系统参考）。系统校准也可能需要稍微的参考电压不同于5.000 V，例如5.12 V（二进制应用）蒸发散。在任何一种情况下，可选的微调电路如图6所示可以以最小的影响将输出抵消多达300mV在其他设备的特点。

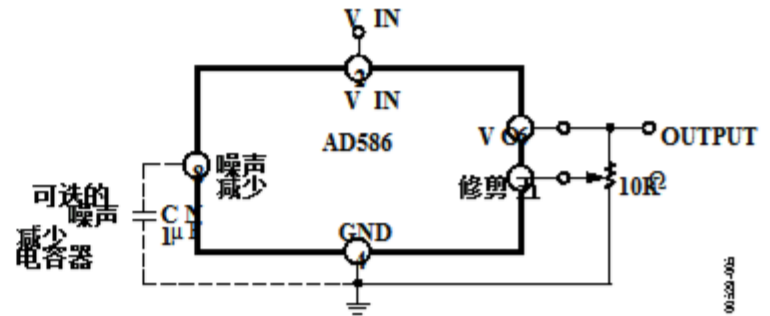


图6. 可选的微调配置

噪音表现和减少

AD586产生的噪声通常小于4μVpp
在0.1Hz至10Hz的频带上。1 MHz带宽的噪声是大约200μVpp。这种噪声的主要来源是埋入式齐纳二极管，其贡献大约100 nV / √Hz。相比之下，运算放大器的贡献可以忽略不计。图7显示典型AD586的0.1 Hz至10 Hz噪声。噪声用1极的带通滤波器进行测量。转角频率为0.1 Hz的高通滤波器和2极低频滤波器，转角频率为12.6 Hz，创建一个以9.922 Hz的带宽过滤。

如果需要进一步降低噪音，可以使用外部电容器在降噪引脚和地面之间加入，如图所示。如图6所示。这个电容结合了4kΩ的R S和齐纳电阻，在输出端形成一个低通滤波器的齐纳细胞。一个1μF的电容在3 dB处有一个点12赫兹，并将降低高频（至1兆赫）的噪音大约160μVpp。图8显示了典型的1 MHz噪声AD586，带和不带1μF电容。

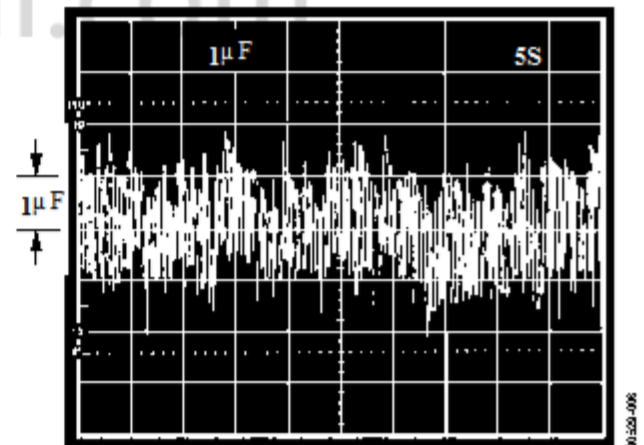
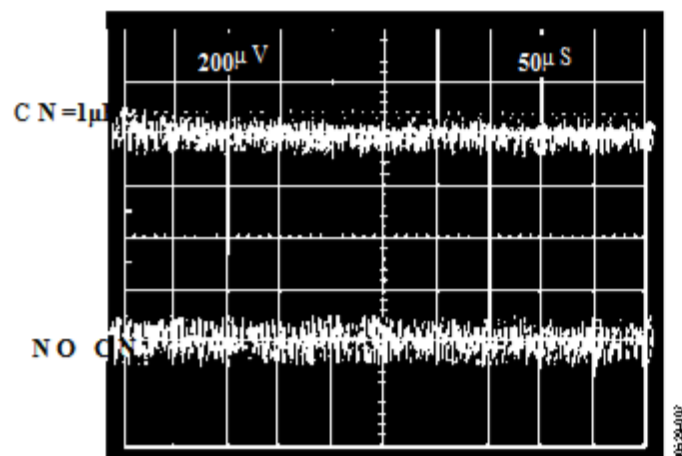


图7. 0.1 Hz至10 Hz噪声

图8. 1 μ F降噪电容对宽带噪声的影响

开启时间

应用电源（冷启动），所需时间
输出电压在规定的范围内达到其最终值
误差带定义为导通建立时间。两个组合 -
通常与此相关的是正在活动的时间
电路来解决，和热梯度的时间
芯片稳定。图9，图10和图11显示了
AD586的导通特性。它显示了安定
大约60 μ s到0.01%。注意没有任何热尾巴
当水平刻度在图10中扩展到1ms / cm时。

当外部噪声降低时输出开启时间被修改，
使用电容器。当出现时，这个电容器就像一个
内部齐纳电流源的额外负载
二极管，导致开启时间稍长。在这种情况下
的1 μ F电容，初始导通时间近似
400毫秒到0.01%（见图11）。

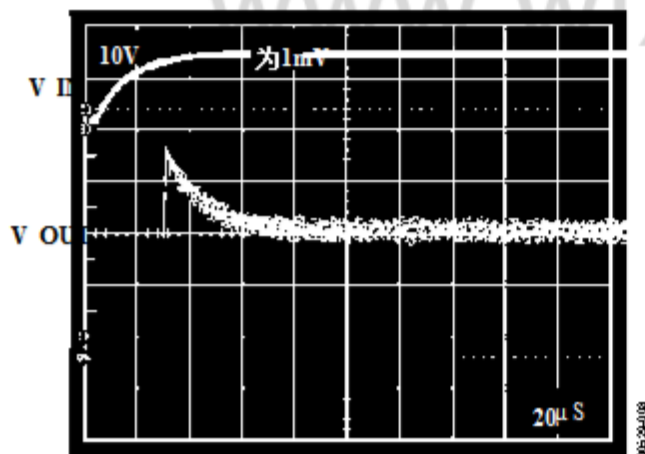


图9.电气开启

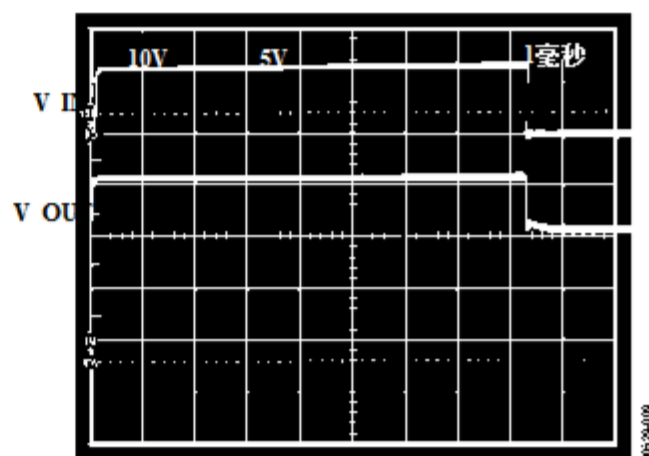
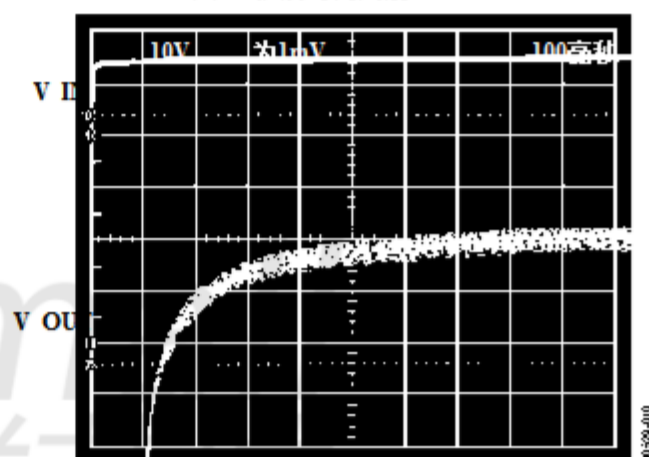


图10.扩展时间尺度

图11.1 μ FC N特性导通

动态表现

输出缓冲放大器旨在提供AD586
具有静态和动态负载调节优于较少com-
完整的参考。

许多ADC和DAC给瞬态电流负载
参考文献和参考反应差，
转换器的性能。

图12，图13和图14显示的特性
AD586输出放大器驱动0 mA至10 mA的负载。

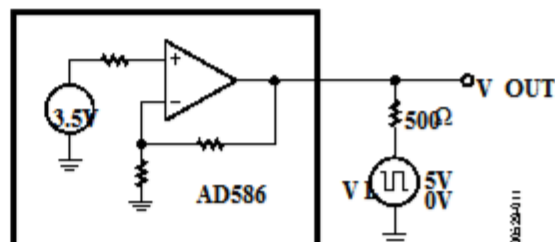


图12.瞬态负载测试电路

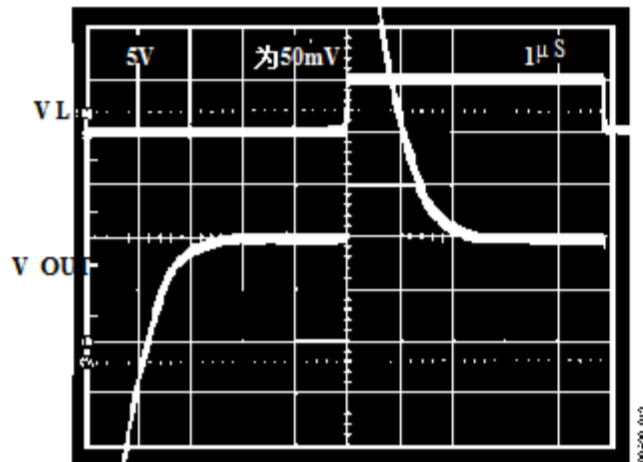


图13.大规模瞬态响应

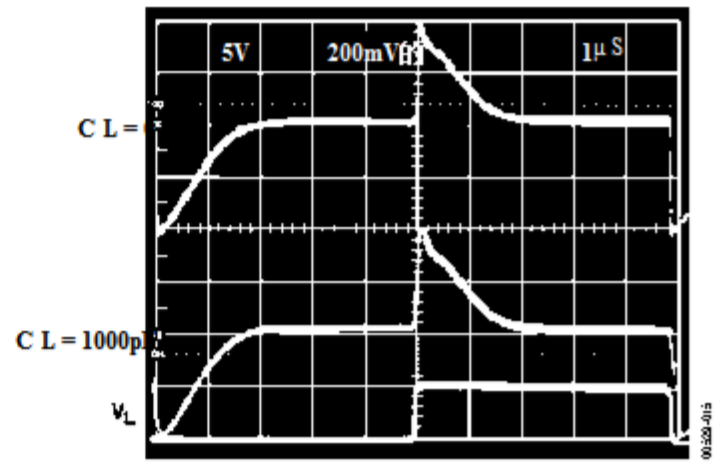


图16.容性负载的输出响应

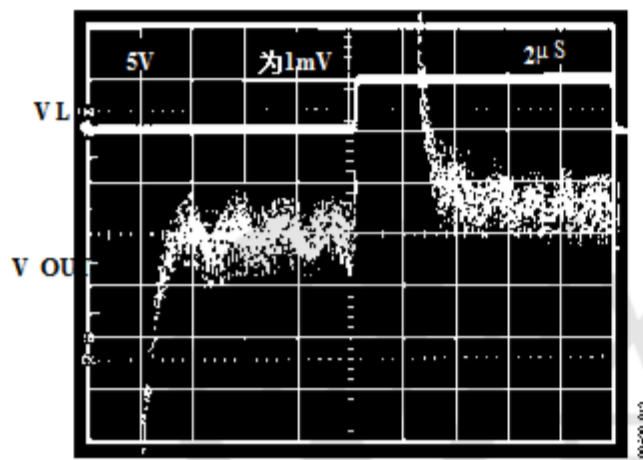


图14.瞬态负载的精细设置

在某些应用中,变化的负载可能既有电阻又有电阻电容性,或负载可能连接到AD586由一条长的电容电缆。

图15和图16显示了输出放大器驱动1000 pF, 0 mA至10 mA负载的特性。

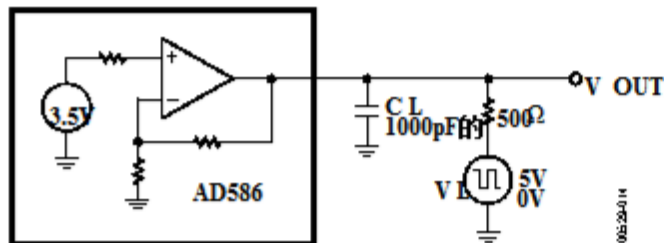


图15.容性负载瞬态响应测试电路

负载调节

AD586具有出色的负载调节特性.图17表明,改变负载几个毫安改变输出一个几μV. AD586具有更好的负载调整率,产生的电流比吸收电流大。

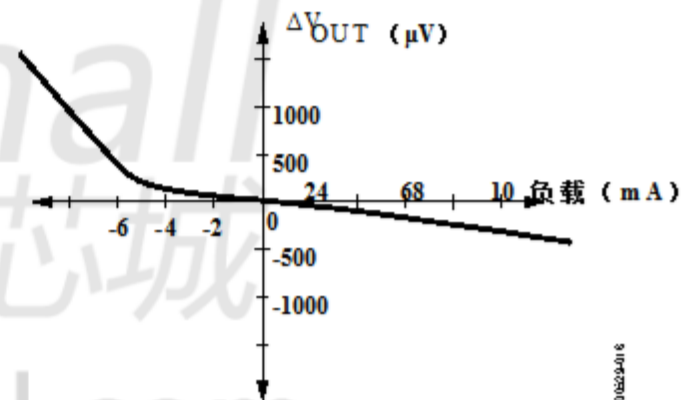


图17.典型的负载调节特性

温度性能

AD586专为精密参考应用而设计.温度性能至关重要.广泛的温度测试确保设备保持高水平性能超过工作温度范围。

定义和指定引用存在一些混淆.电压误差超过温度.历史上,参考文献有使用每度最大偏差来表征摄氏度,即ppm/°C.但是,由于中的非线性起源于标准齐纳的温度特性.参考文献(如“S”型特征),大多数制造商已经开始使用最大限度误差带的方法来指定设备.这项技术涉及测量输出三个或更多不同温度来指定输出电压 - 年龄误差带。

图18显示了AD586L的典型输出电压漂移并说明了测试方法.图18中的框是在极端工作温度的两侧是有限的并在最高和最低的顶部和底部在工作温度下测量的输出电压范围.从左下角到右斜的斜率盒子的右上角决定了表演设备的等级.

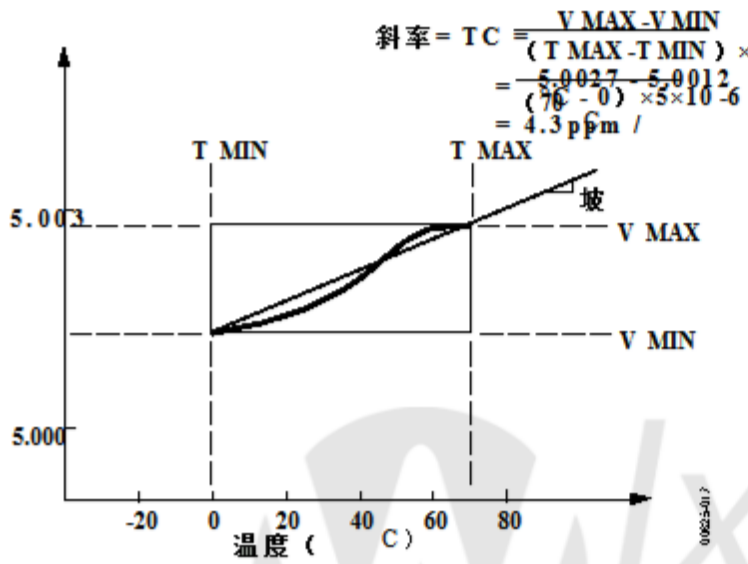


图18.典型的AD586L温漂

每个AD586J, AD586K和AD586L级单元均在0°C下进行测试, 25°C和70°C.每个AD586SQ和AD586TQ级单元是在-55°C, + 25°C和+ 125°C下进行测试.这种方法确保了输出电压随温度而变化在指定的范围内的变化将被包含在一个其斜率等于所规定的最大值.垂直档位上的框的位置将改变从设备到设备作为初始误差和曲线的形状变化.箱子的最大高度为适当的tem-表5中示出了温度范围和器件等级.这些结果的阳离子需要高精度的组合并在测试系统中进行稳定的温度控制.评估AD586将产生类似于图18的曲线,但是输出读数可能会根据测试方法而有所不同使用的设备.

表5.最大输出变化 (mV)

设备 年级	最大输出变化 (mV)		
	0°C至70°C	-40°C至+ 85°C	-55°C至+ 125°C
AD586J	8.75		
AD586K	5.25		
AD586L	1.75		
AD586M	0.70		
AD586A		9.37	
AD586B		3.12	
AD586S			18.00
AD586T			9.00

AD586的负向参考电压

AD586可用于提供精确的-5.000 V输出, 如图19所示.V IN 引脚连接至少6 V电源, 输出引脚接地, 并且AD586接地引脚被连接通过电阻RS连接到-15 V电源. -5 V输出现在从地面引脚 (引脚4) 取代V OUT.它是必须安排输出负载和电源电阻RS, 这样通过AD586的净电流在2.5 mA之间和10.0毫安.温度特性和长期性装置的稳定性将基本上与a相同在标准+ 5V输出配置中使用的单位.

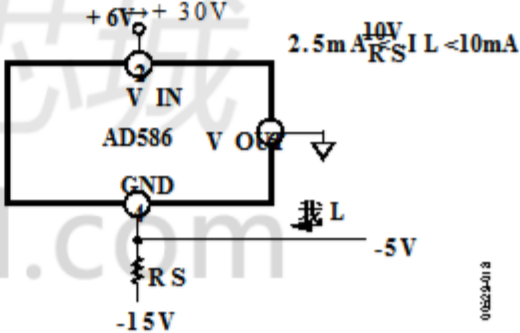


图19. AD586作为负5V参考

使用AD586和转换器

AD586是各种8位, 12位, 14位, 和16位ADC和DAC.几个代表性的例子是在下面的部分解释.

5 V参考倍增 CMOS DAC或ADC

AD586非常适合10位和12位应用
乘以CMOS DAC.在标准的连接中, 如图所示
在图20中, AD586与12位的AD7545配对
乘法DAC和AD711高速BiFET运算放大器.
放大器DAC配置产生一个单极性0V至
-5 V输出范围.双极输出应用等
操作细节可以在个别产品数据中找到
床单.

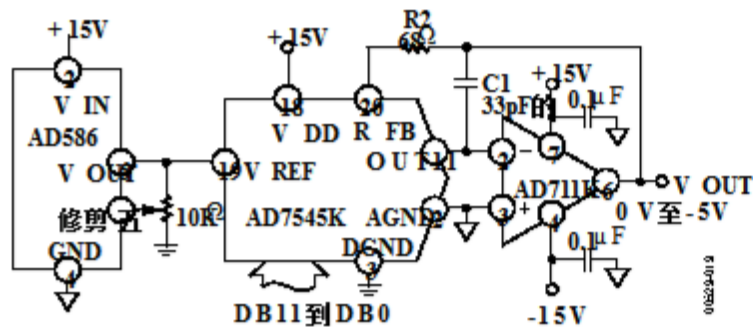


图20.低功耗12位CMOS DAC应用

AD586也可以用作多功能电源的精密基准电压源,
ple DACs.图21显示了AD586, AD7628双DAC,
和AD712双路运算放大器连接起来,
产生0 V至-5 V的输出.因为两个DAC都打开了
相同的模具, 并共享一个共同的参考和输出操作
安培, DAC输出将显示类似的增益TC.

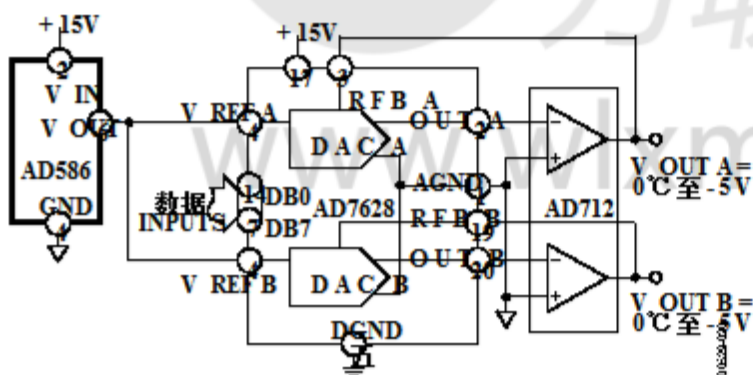


图21. AD586作为CMOS的5 V基准

STACKED精密参考 多个电压

通常, 设计需要几个参考电压.三
AD586可以堆叠, 如图22所示, 以生产
5.000 V, 10.000 V和15.000 V输出.这个方案可以
扩展到任何数量的AD586, 提供了最大的
不超过负载电流.这个设计提供了 addi-
改善5.0 V线路调整的优势
输出. 18 V至50 V的 V_{IN} 变化产生输出变化
低于参考的噪音水平.

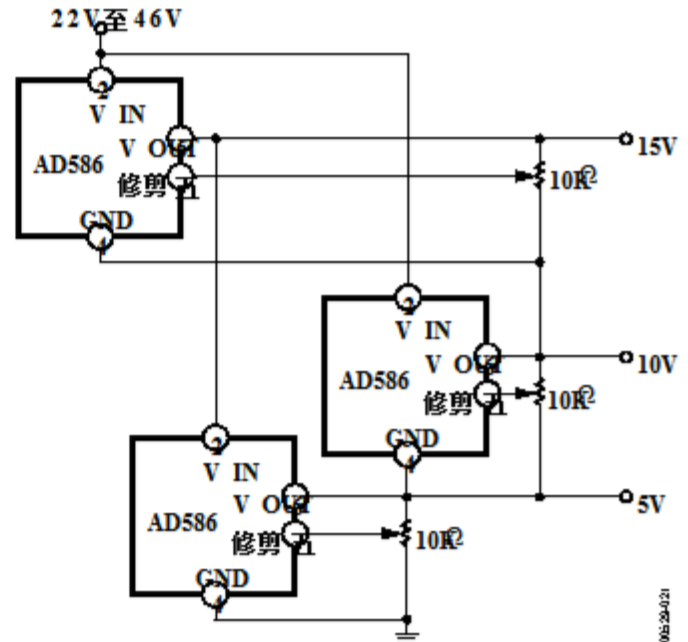


图22.精密5 V, 10 V和15 V输出的多个AD586堆叠

精密电流源

AD586的设计使其可以轻松配置为
当前来源. 通过选择 图23中的控制电阻 R_C ,
用户可以从静态电流改变负载电流
(通常为2mA) 至大约10mA.合规性电压 -
这个电路的年龄从5V到21V不等, 取决于
 V_{IN} 的值.

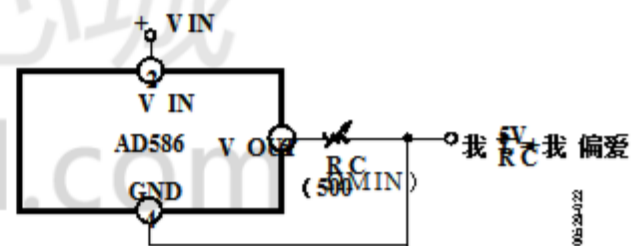


图23.精密电流源

精密高电流供电

对于更高的电流, AD586可以很容易地连接到一个
电源PNP或电源达林顿PNP设备.在电路中
图24和图25可以为负载提供高达4安培的电流.
只有负载很重要时, 才需要0.1μF的电容
电容分里.如果负载是纯粹的电阻, 改善
高频电源抑制结果可以通过
取下电容器.

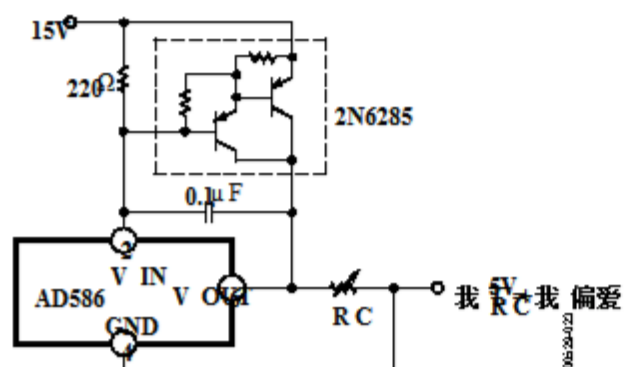


图24.精密高电流电流源

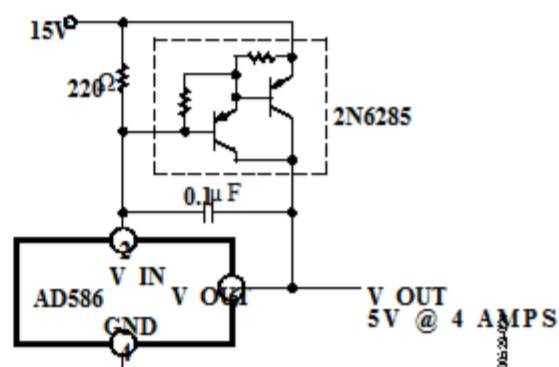
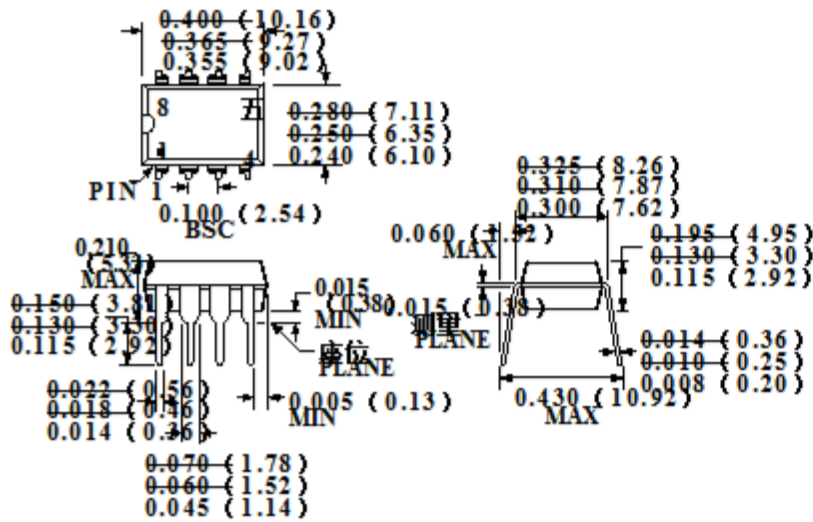


图25.精密高电流电压源

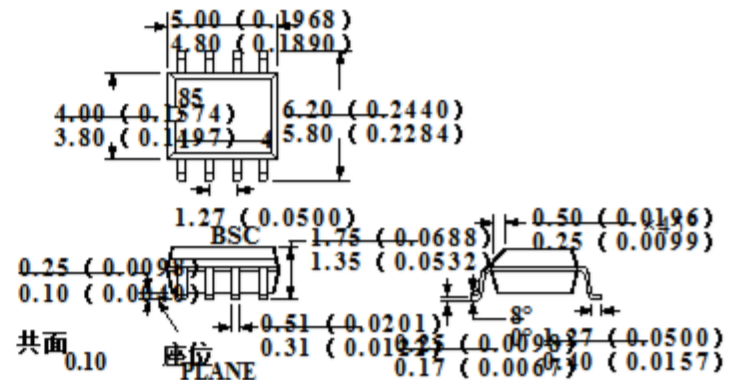
 **Lxmall**
万联芯城
www.wlxmall.com

外形尺寸



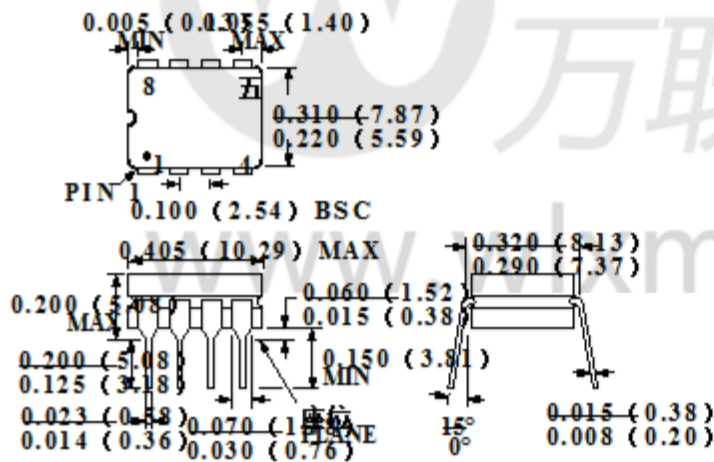
符合JEDEC标准MS-001-BA
控制尺寸为英寸;毫米尺寸
仅供参考,不适用于设计。

图26. 8引脚塑料双列直插式封装[PDIP]
(N-8)
尺寸以英寸和(毫米)



符合JEDEC标准MS-012AA
控制尺寸为英寸;毫米尺寸
(在括号里)是毫米级的毫米等值
仅供参考,不适用于设计。

图28. 8引脚标准小型封装[SOIC]
狭窄的身体
(R-8)
尺寸以毫米和(英寸)



控制尺寸为英寸;毫米尺寸
仅供参考,不适用于设计。

图27. 8引脚陶瓷双列直插式封装[CERDIP]
(Q-8)
尺寸以英寸和(毫米)

AD586

订购指南

模型	初始 错误	温度 系数	温度 范围	包 描述	包 选项	数量每个 卷轴
AD586JN	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586JNZ1	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586JQ	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	CERDIP	Q-8	
AD586JR	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	
AD586JR-REEL7	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	1000
AD586JRZ1	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	
AD586JRZ-REEL71	20毫伏	25 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	1000
AD586KN	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586KNZ1	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586KQ	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	CERDIP	Q-8	
AD586KR	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	
AD586KR-REEL	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	2500
AD586KR-REEL7	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	1000
AD586KRZ1	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	
AD586KRZ-REEL1	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	2500
AD586KRZ-REEL7	5毫伏	15 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	1000
AD586LN	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586LNZ1	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586LR	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	
AD586LR-REEL	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	2500
AD586LR-REEL7	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	1000
AD586LRZ1	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	
AD586LRZ-REEL1	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	2500
AD586LRZ-REEL71	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	SOIC	R-8	1000
AD586MN	2毫伏	2 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586MNZ1	2毫伏	2 ppm / °C	0°C至70°C	PDIP	N-8	
AD586AR	5毫伏	15 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	
AD586AR-REEL	5毫伏	15 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	2500
AD586ARZ1	5毫伏	15 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	
AD586ARZ-REEL1	5毫伏	15 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	2500
AD586ARZ-REEL7	5毫伏	15 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	1000
AD586BR	2.5毫伏	5 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	
AD586BR-REEL7	2.5毫伏	5 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	1000
AD586BRZ1	2.5毫伏	5 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	
AD586BRZ-REEL1	2.5毫伏	5 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	2500
AD586BRZ-REEL71	2.5毫伏	5 ppm / °C	-40°C至+85°C	SOIC	R-8	1000
AD586LQ	2.5毫伏	5 ppm / °C	0°C至70°C	CERDIP	Q-8	
AD586SQ	10毫伏	20 ppm / °C	-55°C至+125°C	CERDIP	Q-8	
AD586TQ	2.5毫伏	10 ppm / °C	-55°C至+125°C	CERDIP	Q-8	
AD586TQ / 883B2	2.5毫伏	10 ppm / °C	-55°C至+125°C	CERDIP	Q-8	

1 Z = 无铅部分。

2 关于根据MIL-STD-883筛选的等级和封装产品的详细信息，请参考ADI公司军用产品数据手册或目前AD586 / 883B数据手册。

笔记



笔记

